

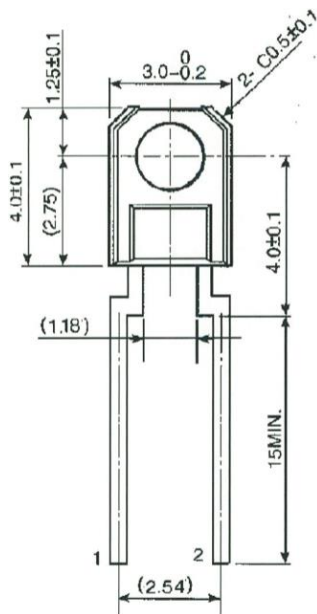
正面



側面



外形



特長

4つの技術を採用し、品質事故リスクを極限まで低減した高い品質と耐久性を実現

1. パラジウムめっきフレーム使用で、高い耐久性を実現

一般的には製品完成後に半田めっきを行います。完成後めっきでは、めっき液が侵入し、品質事故につながる可能性があります。弊社製品は、プレめっきのため、その恐れがありません。

2. 低温アッセンブリで、部材酸化による品質劣化なし

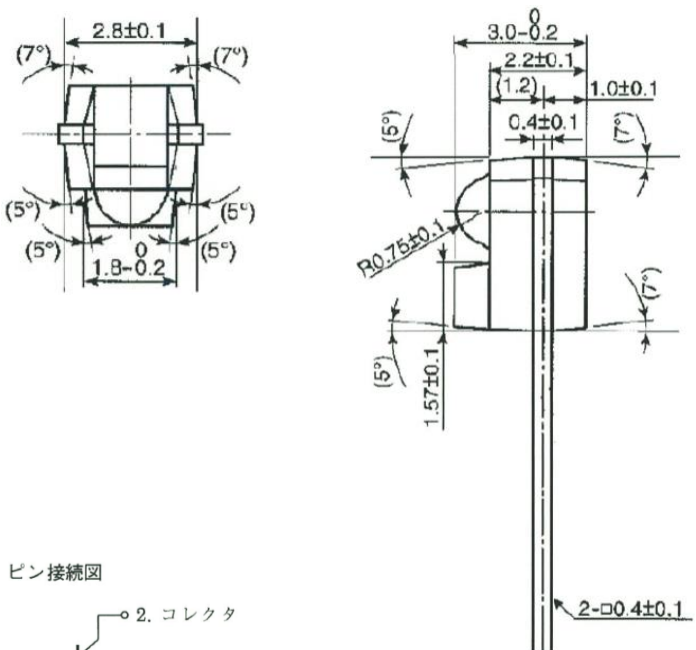
低温速硬化ダイボンドにより、チップ・フレーム・樹脂の高密着性を実現しています。またフレームの酸化防止・不純物の折出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。

3. 高信頼の樹脂/構造の採用

高信頼性モールド樹脂、減圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止。

4. エピウエハーを採用し、大電流域でも安定動作

エピウエハーの採用により、 $V_{ce(sat)}$ が他社比較で40%程度低く、段電流域でも安定動作を実現しています。



ピン接続図



※ () は参考値

定格及び特性

絶対最大定格

Ta=25°C

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・コレクタ間電圧	V_{ECO}	5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	75	mW
コレクタ損失低減率(T a>25°C)	$\Delta P_C / ^\circ C$	-1	mw/°C
動作温度	T_{opr}	-30 ~ +95	°C
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +100	°C
はんだ付け温度(5 s)	T_{sol}	260 *1	°C

*1: リード根元より2mm以上

電氣的及び光学的特性

Ta=25°C

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
暗電流	I_{CEO}	$V_{CE}=24V, E=0$	-	0.005	0.1	μA
光電流	I_L	$E=0.1mW/cm^2$ $V_{CE}=3V$	50	130	210	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$E=0.1mW/cm^2$ $I_L=15\mu A$	-	0.15	0.4	V
ピーク感度波長	λ	-	-	870	-	nm
半値角	1/2θ	-	-	±15	-	°
応答時間	上昇時間	$V_{CE}=5V, I_C=2mA,$ $R_L=100\Omega$	-	6	-	μs
	下降時間		-	6	-	μs

